



## NEWS RELEASE

報道資料

2008年12月10日

(日本時間)

アプライド マテリアルズ 新しい絶縁膜エッチング装置 **Enabler E5** を発表、  
32nm メモリチップにおけるコンタクトエッチングの課題を解決

アプライド マテリアルズ (Applied Materials, Inc., Nasdaq : AMAT、本社 : 米国カリフォルニア州サンタクララ、社長兼 CEO マイケル・スプリンター) は 12 月 2 日 (現地時間)、絶縁膜エッチング装置 **Applied Centura® Enabler® E5** を発表しました。これは、32nm 以降の DRAM やフラッシュメモリチップの歩留まりと性能の確保に欠かせない高アスペクト比 (40:1) コンタクトの形成に適した業界最先端のソリューションです。**Enabler E5** はプロファイル制御における従来の基準を塗り替え、ウェーハ全面にわたってコンタクトのトップ径とボトム径の比率が 80% 以上、コンタクト側壁のボーイングが 3nm 以下という次世代の安定した高性能メモリデバイスの製造を可能にします。

アプライド マテリアルズのバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャー (エッチ&クリーン ビジネスユニット)、エリー・イーは次のように述べています。「次世代のフラッシュメモリや DRAM デバイスに向けた絶縁膜エッチングでは、高アスペクト比コンタクトの形成に必要な全般的プロファイル制御が大きな課題となっていました。**Enabler E5** はその要件をすべて満たす唯一の装置で、メーカーはこれを利用して引き続きメモリ密度の向上とビット単価の低減を図ることができます」

イーはさらにこう付け加えています。「**Enabler E5** の抜群のプロファイル制御性能は、お客様から大きな注目を集めています。すでに世界各地で複数台が設置されており、他の装置と実環境で性能比較を行って **Enabler E5** の優秀性を確認した複数の大手メモリメーカーからリピート注文をいただいています」

**Enabler E5** は、独自のリアクター設計と精密なプロセス制御によって、均一な高アスペクト比の垂直プロファイルを各ウェーハ面の随所で再現可能にし、高メモリ密度デバイスの歩留まり低下をもたらす要因に対処しています。さらに独自のチャンバ技術でクリーニング効率を高め、メンテナンス間隔は他の装置に比べて 50% 以上長くなっています。

Applied Centura Enabler E5 の詳細情報については、  
[www.appliedmaterials.com/products/dielectric\\_etch\\_enabler\\_4.html](http://www.appliedmaterials.com/products/dielectric_etch_enabler_4.html) をご参照ください。

アプライド マテリアルズは、半導体チップ、フラットパネル、太陽電池、フレキシブルエレクトロニクス、省エネガラスの製造におけるイノベティブな装置、サービスおよびソフトウェア製品を幅広く提供する Nanomanufacturing Technology™ ソリューションのグローバルリーダーです。アプライド マテリアルズは、人々のライフスタイルを向上させるナノマニュファクチャリングテクノロジーを提供します。

詳しい情報はホームページ：<http://www.appliedmaterials.com> でもご覧いただけます。

\*\*\*\*\*  
このリリースは 12 月 2 日米国においてアプライド マテリアルズが行った英文プレスリリースをアプライド マテリアルズ ジャパン株式会社が翻訳の上、発表するものです。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社(本社:東京都、代表取締役社長:渡辺徹)は 1979 年 10 月に設立。大阪支店ほか 12 のサービスセンターを置き、日本の顧客へのサポート体制を整えています。

このリリースに関する詳しいお問い合わせは下記へ

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社  
〒108-8444 港区海岸 3-20-20 ヨコソーレインボータワー  
社長室：大橋 百合 (Tel: 03-6812-6801 / Fax: 03-6812-6831)  
ホームページ：<http://www.appliedmaterials.com>

---